

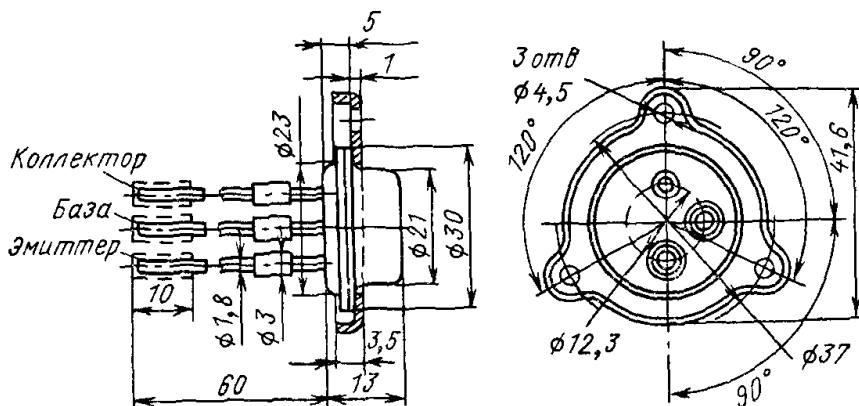
ГТ701А

Транзистор германиевый сплавной *p-n-p* универсальный низкочастотный мощный

Предназначен для работы в схемах усилителей мощности низкой частоты, в импульсных и ключевых схемах

Выпускается в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 25 г, крепежного фланца не более 7,5 г



Электрические параметры

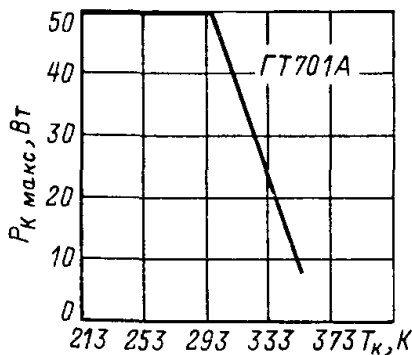
Граничное напряжение при $I_{\text{Э}} = 2,5 \text{ А}$ не менее	
при $T = 298 \text{ К}$	100 В
при $T = 343 \text{ К}$	90 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КЭ}} = 2 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 5 \text{ А}$ не менее	10
Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КБ}} = 20 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 0,1 \text{ А}$ не менее	50 кГц
Обратный ток коллектора при $U_{\text{КБ}} = 60 \text{ В}$ не более:	
при $T = 298 \text{ К}$	6 мА
при $T = 343 \text{ К}$ и $T = 218 \text{ К}$	30 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{\text{КЭ}} = 100 \text{ В}$, $U_{\text{БЭ}} = 1,5 \text{ В}$ не более	50 мА

Материал взят из источника:

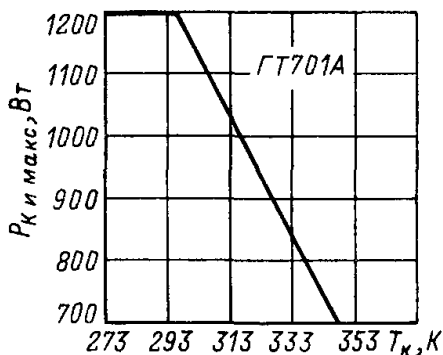
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	55 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} =$ $= 0,5$ В, $\tau_{и} = 1$ мс, $Q \geq 10$	100 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} =$ $= 0,56$ В, $\tau_{и} = 0,3$ мс, $Q \geq 10$	140 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	15 В
Постоянный ток коллектора	12 А
Постоянный ток базы в режиме включения	0,15 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 298$ К	50 Вт
при $T = 328$ К	25 Вт
при $T = 343$ К	8,3 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $\tau_{и} = 1$ мс, $Q \geq 10$:	
при $T = 298$ К	1200 Вт
при $T = 348$ К	700 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	1,2 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 218 до 343 К



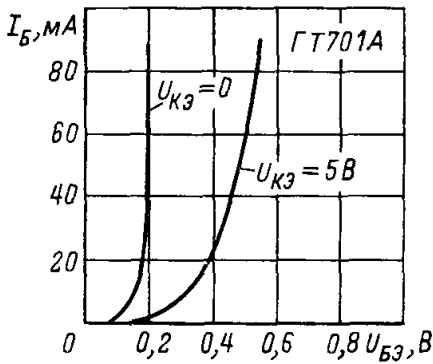
Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.



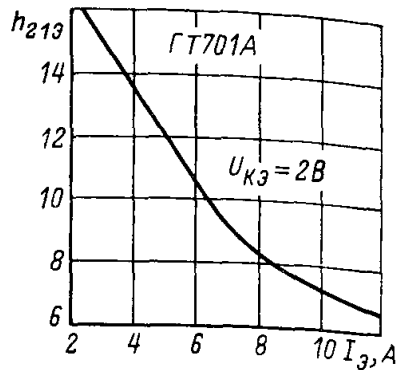
Зависимость максимально допустимой импульсной мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985



Входные характеристики



Зависимость статического коэф-
фициента передачи тока от тока
эмиттера

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985